

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главного научного сотрудника
в лаборатории Неравновесных процессов в полупроводниках
Вакансия VAC_PTI_PSR3-1

Тематика исследований

Исследования и разработки в области физики и технологий полупроводниковых материалов и приборов.

Трудовая деятельность

Постановка задач исследования научному коллективу, организация и руководство проведением исследований физических свойств полупроводниковых материалов и разработки полупроводниковых приборов.

Научное руководство темами исследований согласно госзаданию и планам НИР по утверждённым целевым программам; подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечение выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении.

Непосредственное участие в проведении исследований: разработка методов решения сложных научных проблем; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности соисполнителей работ.

Участие в подготовке научных кадров, повышении их квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в области физики и технологий полупроводниковых материалов и приборов.

Требования к кандидату:

- Наличие ученой степени доктора физико-математических наук.
- Опыт научной работы – не менее 30 лет.
- Число публикаций, цитирований и индекс Хирша (РИНЦ) – не менее 200, 1500, 17 соответственно.
- Опыт научно-организационной работы по руководству научным коллективом, организации и выполнению проектов научных фондов, НИОКР, Президиума РАН, ПФНИ ГАН – не менее 20 лет.
- Опыт создания результатов интеллектуальной деятельности, учитываемых в государственных информационных системах, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ.
- Опыт работы по подготовке специалистов с высшим образованием в области физики и технологий полупроводниковых материалов и приборов, звание профессора.
- Опыт работы в редакционных коллегиях российских научных журналов физико-технологического профиля.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;

- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).